## 13,03

# Электронно-стимулированная десорбция атомов лития из слоев лития на поверхности Li<sub>x</sub> Au<sub>y</sub>

© Ю.А. Кузнецов, М.Н. Лапушкин

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия E-mail: lapushkin@ms.ioffe.ru

Поступила в Редакцию 27 мая 2021 г. В окончательной редакции 27 мая 2021 г. Принята к публикации 2 июня 2021 г.

> Впервые созданы полупроводниковые 2D-слои  $Li_xAu_y$  на поверхности золота, напыленного на вольфрамовую подложку. Исследованы процессы электронно-стимулированной десорбции атомов Li в системе Li/Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>/Au/W. Показано, что процессы электронно-стимулированной десорбции происходят в монослое Li и ближайшем к нему слое Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>. Предложена модель электронно-стимулированной десорбции атомов Li в системе Li/Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>/Au/W.

> Ключевые слова: электронно-стимулированная десорбция, литий, золото, полупроводник, интерметаллид.

DOI: 10.21883/FTT.2021.10.51460.127

## 1. Введение

Облучение электронами поверхности твердого тела может приводить к десорбции атомов и ионов, что открывает возможности для исследования поверхности. Электронно-стимулированная десорбция (ЭСД) атомов наблюдается только с поверхности полупроводников и изоляторов при энергии возбуждающих ЭСД электронов менее 200 eV. С поверхности металлов электронностимулированная десорбция атомов не наблюдается, так как происходит быстрая релаксация возбужденных состояний, которое не позволяет за это время десорбироваться атому. Поэтому с помощью метода ЭСД возможно производить исследования перехода металл-полупроводник (диэлектрик) для адсорбированных слоев и 2D-слоев нанесенных на поверхность. Ранее с помощью ЭСД исследована адсорбция атомов щелочных металлов на различных поверхностях интерметаллидов щелочных металлов (CsAu, NaAu, KAu) [1-4].

Интерметаллиды золото-щелочной металл известны еще с середины прошлого века [5]. Интерметаллиды щелочных металлов с золотом вызывают к себе интерес, так как в них золото выступает в роли аниона [6], а не катиона как в большинстве соединений золота. Еще более удивительным является то, что в ряде случаев интерметаллиды щелочных металлов с золотом могут образовывать полупроводниковые соединения. Процесс синтеза интерметаллидов может происходить не только при высоких температурах, но и при комнатной температуре при напылении атомов щелочных металлов на поверхность золота. Формирование интерметаллида при напылении атомов щелочных металлов на поверхность приводит к созданию 2D-пленок интерметаллида с толщиной от одного монослоя интерметаллида и более.

Интерметаллид CsAu является полупроводником, что было показано как для массивных образцов [5,7,8], так и для 2D-пленок интерметаллида [2,9]. Расчеты методом функционала плотности (DFT) показывают, что интерметаллид CsAu является широкозонным полупроводником с шириной запрещенной зоны 2.6 eV [10]. Расчеты методом функционала плотности электронной структуры для интерметаллидов LiAu, KAu, NaAu [11], NaAu<sub>2</sub> [12], LiAu<sub>5</sub>, NaAu<sub>5</sub>, KAu<sub>5</sub> [13] показывают, что эти интерметаллиды являются металлами. Однако ряд экспериментов, выполненных с помощью метода ЭСД, показывают, что 2D-пленки интерметаллидов K<sub>x</sub>Au<sub>v</sub> [1] и Na<sub>x</sub>Au<sub>y</sub> [2], полученным при T = 300 K, являются полупроводниками. Причем стоит отметить, что полученный при  $T \sim 1000 \,\mathrm{K}$  интерметаллид  $\mathrm{Na}_{x}\mathrm{Au}_{y}$  [14] является широкозонным полупроводником с шириной запрещенной зоны 2.7 eV. Также было показано, что и полученный при  $T \sim 1000 \,\mathrm{K}$  интерметаллид  $\mathrm{K}_{x}\mathrm{Au}_{v}$ явлется полупроводником [4].

Процесс формирования интерметаллидов щелочных металлов с золотом при температурах близких к комнатным происходит в несколько стадий. При напылении на золото пленки щелочного металла менее одного монослоя не происходит диффузии атомов щелочных металлов в золото и, следовательно, не происходит формирование интерметаллида золото-щелочной металл. При напылении на поверхность золота дозы щелочного металла более одного монослоя приводит к диффузии атомов щелочного металла в золото с формированием интерметаллидов золото-щелочной металл различной стехиометрии. Следует отметить, что при таком способе создания интерметаллида на поверхности всегда будет присутствовать монослой щелочного металла.

В [15] показано, что пленка Li-Au, полученная при насыщении атомами Li пленки золота толщиной

5 монослоев, имеет металлический характер. Этот факт подтверждается рассчитанным металлическим характером соединения Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub> [11,13].

Исследованиям адсорбции атомов Li на золоте и их взаимодействию было уделено меньше всего внимания по сравнению с исследованиями адсорбции других щелочных металлов на золото. Так, например, в [16] было показано формирование сплава Au–Li в золотом электроде в электрохимической ячейке, с электролитом, в составе которого содержится LiPF<sub>6</sub>. В последние годы началось исследование Au<sub>x</sub>Li<sub>y</sub> нанобъектов, например, в [17] созданы наночастицы LiAu с размером 5 nm и были исследованы колебательные свойства этих наночастиц. Фазовая диаграмма системы Au–Li была опубликована в [18].

Целью настоящей работы было создать 2D-пленку интерметаллида  $Li_x Au_y$ , детально рассмотреть физические процессы, протекающие при облучении электронами системы  $Li/Li_x Au_y$ , и на этой основе предложить модель ЭСД атомов Li в этой системе.

## 2. Эксперимент

#### 2.1. Материалы

В качестве подложки исследуемых образцов использовались вольфрамовые ленты. Ленты предварительно прогревали при 1800 К в атмосфере кислорода при давлении  $1 \cdot 10^{-6}$  Torr в течение 3 h. Золото напыляли на ленту при 300 К из прямонакальной вольфрамовой трубки, в которую были помещены куски золотой фольги с чистотой 99.99%. Литий напыляли на ленту при T = 300 К из прямонакального испарителя путем термического восстановления окиси лития алюминием. Концентрация атомов лития на поверхности ленты определялась по времени напыления постоянным потоком, интенсивность которого измерялась по току поверхностной ионизации на Ir ленте, и составляла в монослое атомов лития  $1.0 \cdot 10^{15}$  atom/cm<sup>2</sup>. Концентрация напыленного Au определялась по времени напыления при постоянном потоке Au, который калибровался с помощью термодесорбционной спектроскопии, и составляла в монослое атомов золота  $1 \cdot 10^{15}$  atom/cm<sup>2</sup>. Эксперименты были выполнены при 300 К.

## 2.2. Приготовление образцов

Использовались два способа приготовления образцов. В первом случае, на чистую вольфрамовую ленту при комнатной температуре напыляли фиксированное количество золота, после чего напыляли необходимое для измерений ЭСД варьируемое количество атомов лития. После проведения измерений поверхность вольфрама очищалась и приготавливалась заново. Во втором случае, на чистую вольфрамовую ленту при комнатной температуре напыляли необходимое для измерений ЭСД варьируемое количество золота, после чего напыляли



**Рис. 1.** Схема эксперимента. *1* — образец, *2* — источник электронов, *3* и *4* — Аи и Li испарители, *5*, *6* — электроды, задерживающие ионы, десорбирующихся при электронном облучении образца, *7* — коллектор ионов, *8* — поверхностная ионизационная лента.

фиксированное количество атомов лития. После проведения измерений поверхность вольфрама также очищалась и готовилась заново.

# 2.3. ЭСД

Предлагаемые в данной работе исследования проведены сверхвысоковакуумной установке "Спектрометр ЭСД", схема эксперимента приведена на рис. 1. Давление остаточных газов в установке не превышало  $5 \cdot 10^{-10}$  Torr. Эксперименты проводили при T = 300 K.

Вольфрамовую ленту с нанесенным на нее слоем  $\text{Li}_x \text{Au}_y$  облучали пучком электронов с энергией в диапазоне 0–200 eV. Десорбирующиеся при этом атомы Li ионизировались на нагретой до T = 2000 K иридиевой ленте. Вероятность поверхностной ионизации атомов Li на иридии при такой температуре равна единице [19].

ЭСД атомов характеризуется величиной выхода ЭСД q, равной отношению плотности десорбирующегося потока атомов к плотности потока возбуждающих ЭСД электронов. Установка "Спектрометр ЭСД" позволяла регистрировать выход ЭСД атомов цезия q, измерять зависимость этого выхода q от энергии возбуждающих электронов, количества нанесенного на подложку Li и золота.

## 3. Результаты и обсуждение

ЭСД атомов Li с поверхности одного монослоя Au напыленного на W(100) не наблюдается ни при каких покрытиях Li, т. е. не происходит реакции атомов лития с атомами золота в монослойной пленке Au на W(100). Это согласуется с ранее полученными результатами по исследованию адсорбции атомов Na, K и Cs на монослойной пленке золота, когда ЭСД атомов щелочных металлов не наблюдается [4–6] и исследованиями адсорбции атомов натрия и цезия на пленках золота, напыленных на вольфрам [20]. Если же нанесено покрытие



**Рис. 2.** Выход q атомов Li при ЭСД с вольфрама, покрытого двумя монослоями золота, при T = 300 K в зависимости от концентрации адсорбированного лития  $n_{\rm Li}$  для энергии бомбардирующих электронов 64 eV. Схемы при напылении Li и Au на W: a - для 2 монослоев Au и 1 монослоя Li; b - для 2 монослоев Au и 2 монослоев Li с образованием 2D-слоя LiAu; c - для 2 монослоев Au и 2.5 монослоев Li с образованием 2D-слоя LiAu.

Au больше, чем 1 монослой, то при напылении атомов лития, возможно, регистрировать ЭСД атомов лития.

На рис. 2 показана зависимость выхода ЭСД  $q(n_{\rm Li})$  атомов Li с поверхности W, покрытого двумя монослоями Au, при  $T = 300 \,\text{K}$  от поверхностной концентрации Li, адсорбированного на поверхности Au/W. При дозе напыления атомов лития менее, чем  $1.0 \cdot 10^{15}$  atom/cm<sup>-2</sup> (1 монослой), ЭСД атомов Li не наблюдается и не формируется соединение Li<sub>x</sub>Au<sub>v</sub> (схема а на рис. 2). При дозе напыления атомов лития больше, чем  $1.0 \cdot 10^{15}$  atom/cm<sup>-2</sup> (1 монослой) начинает наблюдаться ЭСД атомов Li. Это означает, что в промежутке между верхним монослоем атомов лития и ближайшим к поверхности вольфрама монослоем золота начинает формироваться полупроводниковая пленка Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>. Увеличение дозы напыленных атомов Li приводит к линейному росту q вплоть до дозы напыленного  $n_{\rm Li} = 1.8 \cdot 10^{15} \, {\rm atom/cm^2}$ . Дальнейшее напыление атомов лития приводит к замедлению роста выхода ЭСД атомов Li, а при  $n_{\text{Li}} = 2.0 \cdot 10^{15} \text{ atom/cm}^2$  (2 монослоя) наблюдается максимум выхода ЭСД атомов Li. Такое поведение можно объяснить тем, что происходит дальнейшее формирование 2D-слоя Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub> между верхним монослоем атомов лития и ближайшим к поверхности вольфрама монослоем золота. Продолжение напыления атомов Li приводит к уменьшению выхода ЭСД атомов Li. Мы предполагаем, что при напылении дозы  $n_{\rm Li} > 1.0 \cdot 10^{15} \, {\rm atom/cm}^2$  происходит формирование полупроводникового соединения Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub> с дефицитом атомов лития в соединении, а при напылении дозы  $n_{\rm Li} = 2.0 \cdot 10^{15}$  atom/cm<sup>2</sup> происходит формирование полупроводникового соединения LiAu (схема *b* на рис. 2). При дозе напыления  $n_{\text{Li}} > 2.0 \cdot 10^{15}$  atom/cm<sup>2</sup> не происходит дальнейшего изменения стехиометрии образовавшегося соединения LiAu. Спад выхода ЭСД атомов Li связан с формированием второго монослоя адсорбированных атомов Li (схема *c* на рис. 2), который препятствует выходу атомов Li в вакуум, как это было показано ранее, например, для системы Na/NaxAuy/Au/W [2].

На рис. З приведены зависимости выхода ЭСД атомов Li от времени напыления атомов Au. т.е. от величины покрытия атомами золота поверхности вольфрама, для трех доз напыления атомов лития:  $n_{\text{Li}}$ :  $1.0 \cdot 10^{15} \text{ atom/cm}^2$ ,  $1.5 \cdot 10^{15} \text{ atom/cm}^2$ и  $2.0 \cdot 10^{15}$  atom/cm<sup>2</sup>, которые можно формально приписать напылению 1.0, 1.5 и 2.0 монослоя Li, соответственно. Сначала проводилось напыление пленки золота на вольфрамовую фольгу, а затем всегда напылялось одно тоже количество атомов лития. Как видно, для времени напыления атомов Au менее 300 s с последующим напылением атомов лития в диапазоне  $n_{\text{Li}} = (1.0-2.0) \cdot 10^{15} \text{ atom/cm}^2$  не приводит к появлению ЭСД атомов Li. За времена меньшие 300 s напыляется менее одного монослоя атомов золота и эти атомы не принимают участие в формировании Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>. При напылении атомов лития в концентрации  $n_{\rm Li} = 2.0 \cdot 10^{15}$  atom/cm<sup>2</sup> на слой золота, который, в свою очередь, напылялся более 300 s, ЭСД атомов лития наблюдается, т.е. происходит формирование 2D-слоя Li<sub>r</sub>Au<sub>v</sub> между верхним слоем атомов лития и ближайшим к поверхности вольфрама монослоем золота. При этом формируется 2D-слой  $Li_x Au_y$  с x < y. Максимальное значение выхода ЭСД атомов Li наблюдается при времени напыления золота 600 s, что соответствует



**Рис. 3.** Выход q атомов Li при ЭСД с вольфрама, покрытого золотом, при T = 300 К в зависимости от времени напыления золота для трех концентраций лития  $n_{\text{Li}}$ :  $I - 1.00 \cdot 10^{15}$  atom/cm<sup>2</sup>,  $2 - 1.50 \cdot 10^{15}$  atom/cm<sup>2</sup>,  $3 - 2.0 \cdot 10^{15}$  atom/cm<sup>2</sup>. Энергия бомбардирующих электронов 64 eV.

формированию 2D-слоя LiAu между верхним монослоем атомов лития и ближайшим к поверхности вольфрама монослоем золота (смотри схему на рис. 2, b). Напыление атомов лития на более толстые пленки золота приводит к уменьшению выхода ЭСД атомов Li. Это можно объяснить так: в формировании Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub> принимает участие только один монослой атомов лития, а с увеличением числа взаимодействующих с атомами Li атомов Au стехиометрия соединения Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub> изменяется в сторону увеличения у и уменьшения х. Можно предположить формирование LiAu4 при времени напыления атомов золота 1600 s. Похожие процессы происходят и при напылении меньшего количества атомов лития  $n_{\rm Li} = 1.5 \cdot 10^{15}$  atom/cm<sup>2</sup> на слой золота. Максимальное значение выхода ЭСД атомов Li наблюдается при времени напыления золота 600 s, что соответствует формированию 2D-слоя LiAu между верхним монослоем атомов лития и ближайшим к поверхности вольфрама монослоем золота и можно предположить формирование 2D-слоя LiAu<sub>2</sub>. Напыление атомов лития на более толстые пленки золота приводит к уменьшению выхода ЭСД атомов Li. Незначительный спад выхода ЭСД атомов Li всего на 15%, может означать либо медленную диффузию атомов лития вглубь слоя золота, либо слабую зависимость вероятности выхода ЭСД атомов Li для Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>, которая зависит от соотношения x/y. Полученный нами 2D-слой состоящий из четырех монослоев Li<sub>x</sub>Au<sub>v</sub> имеет полупроводниковый характер, а полученный в [18] 2D-слой состоящий из пяти монослоев золота, насыщенных атомами лития имеет металлический характер, что может указывать на переход полупроводник-металл при пяти слоях. Это можно объяснить как особенностями формирования слоя Li-Au на Re в [18] и в наших экспериментах, так и тем, что возможно переход полупроводник-металл происходит при напылении атомов Li на золотую пленку толщиной в районе 5 монослоев.

На рис. 4 приведена измеренная при  $T = 300 \, {\rm K}$  зависимость  $q(E_e)$  выхода ЭСД атомов Li от энергии бомбардирующих электронов  $(E_e)$  с поверхности W, покрытого двумя монослоями Au, на поверхность которого был напылен литий  $n_{\text{Li}} = 2.0 \cdot 10^{15} \text{ atom/cm}^{-2}$  (2 монослоя). В зависимости  $q(E_e)$  видно 2 "квазирезонансных" пика с максимумами при 63.5 и 81.4 eV. Эти пики связаны с возбуждением бомбардирующими электронами остовных уровней Au 5p<sub>3/2</sub> и Au 5p<sub>1/2</sub>. Полная ширина на полувысоте составляет 8.8 и 9.4 eV соответственно для остовных уровней Au  $5p_{3/2}$  и Au  $5p_{1/2}$ . Отношение площадей под пиками составляет 0.72, что близко к теоретическому спин-орбитальному расщеплению для уровней Au  $5p_{3/2}$  и Au  $5p_{1/2}$ , которое равно 0.67. Возбуждение остовного уровня Li 1s с энергией связи  $E_b = 54.7 \, {\rm eV}$  не наблюдается. Так, если бы этот уровень возбуждался, то отношение площадей под пиками бы возросло и это отношение зависело бы от количества напыленных атомов лития. Возбуждение остовных уровней Au  $4f_{7/2}$  ( $E_b = 84.0 \,\mathrm{eV}$ ) и Au  $4f_{5/2}$  ( $E_b = 87.6 \,\mathrm{eV}$ ),

если и происходит, то дает незначительный вклад в зависимость  $q(E_e)$ .

Для объяснения процесса ЭСД атомов Li в системе Li/Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>/Au/W воспользуемся идеями, предложенными



**Рис. 4.** Выход q атомов Li при ЭСД с вольфрама, покрытого двумя монослоями золота и двумя монослоями Li, при T = 300 K в зависимости от энергии бомбардирующих электронов  $E_e$ .



**Рис. 5.** Схема процессов ЭСД в системе монослой Li/слой Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>/монослой Au/подложка W. *E*<sub>VBM</sub> — энергия, соответствующая максимуму валентной зоны.

ранее [1,21]. Рассмотрим схему процессов на примере возбуждения бомбардирующими электронами уровня Аи  $5p_{3/2}$  (рис. 5). Электронное облучение образца приводит к возбуждению электрона с остовного уровня Аи  $5p_{3/2}$  (1) в локальное состояние  $E_L$  рядом с дном зоны проводимости ЕСВМ, опустившееся из зоны проводимости, в поле образовавшейся остовной дырки Au  $5p^+$ в запрещенную зону полупроводника Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>. Образовавшаяся дырка Au  $5p^+$  нейтрализуется электроном из валентной зоны (2) в слое Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>. При этом за счет Ожепроцесса происходит выброс электрона (3) в вакуум. Электрон в локальном состоянии Е<sub>L</sub> расположен вблизи дна зоны проводимости *ECBM* (для системы Cs/CsAu он расположен ниже на 50 meV [21]) и он может быть легко захвачен в зону проводимости (4). Электрон из зоны проводимости захватывается (5) на незанятые состояния атома Li в монослое атомов лития с образованием нейтрального атома Li<sup>0</sup> в монослое Li. Образование нейтрального атома Li приводит к увеличению его размера по сравнению с атомом Li в монослое Li, и он выталкивается с поверхности. Следует отметить, что процесс ЭСД атомов Li связан с электронными переходами в области интерфейса: монослой атомов Li и ближайший к нему слой Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>. В нейтрализации дырки Au  $5p^+$  может принять участие также электрон с остовного уровня Li 1s, но это процесс на наш взгляд менее вероятен, так как необходимо дополнительно нейтрализовать дырку Li  $1s^+$ . Точно такие же процессы происходят при электронном возбуждении остовного уровня Au 5*p*<sub>1/2</sub>.

## 4. Заключение

Обнаружена и исследована электронно-стимулированная десорбция атомов Li в системе Li/Li<sub>x</sub>Au<sub>v</sub>/Au/W. Показано, что при адсорбции атомов лития на золоте формируется полупроводниковый 2D-слой LixAuy в промежутке между монослоем лития и монослоем золота, ближайшем к поверхности вольфрама. При напылении двух монослоев золота и лития формируется LiAu. Для более толстых пленок золота в случае напыления на него 2 монослоев лития также формируется 2D-слои с различной стехиометрией Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub> с дефицитом атомов лития. Наблюдается "квазирезонансная" зависимость выхода ЭСД атомов Li от энергии возбуждающих электронов, связанная с возбуждением остовных уровней Аи  $5p_{3/2}$  и Аи  $5p_{1/2}$ . Предложена модель процессов, происходящих в системе Li/Li<sub>x</sub>Au<sub>y</sub>/Au/W. Процесс ЭСД захватывает атомы, расположенные в адсорбированном слое атомов Li и ближайшем к нему слое  $Li_x Au_y$ .

#### Финансирование работы

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-02-00370. Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## Список литературы

- [1] Ю.А. Кузнецов, М.Н. Лапушкин. ФТТ 62, 1949 (2020).
- [2] В.Н. Агеев, Ю.А. Кузнецов, Н.Д. Потехина. ФТТ 55, 2447 (2013).
- [3] В.Н. Агеев, Ю.А. Кузнецов. ФТТ 50, 365 (2008).
- [4] M.V. Knat'ko, M.L. Lapushkin, V.I. Paleev. Phys. Low-Dime. Struct. 9–10, 85 (1999).
- [5] W.E. Spicer, A.N. Sommer, J.G. White. Phys. Rev. 115, 57 (1959).
- [6] M. Jansen. Chem. Soc. Rev. 37, 1826 (2008).
- [7] G.K. Wertheim, C.W. Bates, D.N.E. Buchanan. Solid Status Commun. **30**, 473 (1979).
- [8] M. Skottke-Klein, A. Bottcher, R. Imbeck, S. Kennou, A. Morgante, G. Ertl. Thin Solid Films 203, 131 (1991).
- [9] М.В. Кнатько, М.Н. Лапушкин, В.И. Палеев. Письма в ЖТФ **24**, 48 (1998).
- [10] N.E. Christensen, J. Kollar. Solid Status Commun. 46, 72 (1983).
- [11] G.H. Grosch, K.-J. Range. J. Alloys Compounds 233, 30 (1996).
- [12] R. Sarmiento-Perez, T.F.T. Cerqueira, I. Valencia-Jaime, M. Amsler, S. Goedecker, S. Botti, M.A.L. Marques, A.H. Romero. New J. Phys. 15, 115007 (2013).
- [13] G.H. Grosch, K.-J. Range. J. Alloys Compounds 233, 39 (1996).
- [14] М.В. Кнатько, М.Н. Лапушкин, В.И. Палеев. ЖТФ. **68**, 108 (1998).
- [15] J.A. Rodriguez, J. Hrbek, Y.-W. Yang M. Kuhn, T.K. Sham. Surf. Sci. 293, 260 (1993).
- [16] Z. Zeng, W.-I. Liang, Y.-H. Chu, H. Zheng. Faraday Discuss 176, 95 (2014).
- [17] R.A. Alvarez-Bayona, M. Cortez-Valadez, F. Martínez-Suárezc, J.J. Cruz-Riverad, M. Flores-Acosta. Phys. E 108, 169 (2019).
- [18] В.Н. Агеев, Е.Ю. Афанасьева. ФТТ 48, 2217 (2006).
- [19] U.Kh. Rasulev, E.Ya. Zandberg. Prog. Surf. Sci. 28, 181 (1988).
- [20] G. Kienast, J. Verma, W. Klemm, Z. Anorg. Allgem. Chem. 310, 143 (1961).
- [21] Ю.А. Кузнецов, М.Н. Лапушкин, Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов 7, 333 (2015).

Редактор К.В. Емцев